

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2017-139293

(P2017-139293A)

(43) 公開日 平成29年8月10日(2017.8.10)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
H O 1 L 29/872 (2006.01)	H O 1 L 29/86 3 O 1 E	4 M 1 O 4
H O 1 L 29/41 (2006.01)	H O 1 L 29/44 Y	
H O 1 L 29/47 (2006.01)	H O 1 L 29/48 E	
H O 1 L 29/06 (2006.01)	H O 1 L 29/86 3 O 1 D	
	H O 1 L 29/06 3 O 1 F	
審査請求 未請求 請求項の数 4 O L (全 10 頁) 最終頁に続く		

(21) 出願番号 特願2016-18117 (P2016-18117)
 (22) 出願日 平成28年2月2日(2016.2.2)

(71) 出願人 000003207
 トヨタ自動車株式会社
 愛知県豊田市トヨタ町1番地
 (71) 出願人 000003609
 株式会社豊田中央研究所
 愛知県長久手市横道41番地の1
 (71) 出願人 000004260
 株式会社デンソー
 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地
 (74) 代理人 110000110
 特許業務法人快友国際特許事務所
 (72) 発明者 永岡 達司
 愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動車株式会社内

最終頁に続く

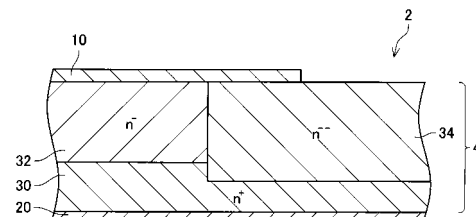
(54) 【発明の名称】 ダイオード

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】 p型半導体層を利用することなく、高い耐圧を実現するSBD (Schottky Barrier Diode) を提供する。

【解決手段】 SBD 2は、半導体基板4と、半導体基板4の上面の一部に接している上面電極10と、半導体基板4の下面に接している下面電極20を備える。半導体基板4は、下面電極20にオーミック接触するn型の高濃度層30と、高濃度層上の一部に形成されており、高濃度層30よりn型不純物濃度が低いn型の中濃度層32と、高濃度層30上において中濃度層32を一巡する範囲に形成されており、中濃度層32よりn型不純物濃度が低いn型の低濃度層34とを備えている。上面電極10は、中濃度層32の上面にショットキー接触している。上面電極10と半導体基板4が接している接触領域は中濃度層32を越えて低濃度層34上に及んでいる。

【選択図】 図1



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

ダイオードであって、
半導体基板と、
前記半導体基板の上面の一部に接している上面電極と、
前記半導体基板の下面の少なくとも一部に接している下面電極を備えており、
前記半導体基板が、
前記下面電極にオーミック接触する n 型の高濃度層と、
前記高濃度層上の一部に形成されており、前記高濃度層より n 型不純物濃度が低い n 型の中濃度層と、
前記高濃度層上において前記中濃度層を一巡する範囲に形成されており、前記中濃度層より n 型不純物濃度が低い n 型の低濃度層を備えており、
前記上面電極が、前記中濃度層の上面にショットキー接触しており、
前記上面電極と前記半導体基板が接している接触領域が、前記中濃度層を越えて前記低濃度層上に及んでいる、
ダイオード。

10

【請求項 2】

前記低濃度層内において前記中濃度層を一巡する範囲に形成されている絶縁層をさらに備えており、
前記接触領域の端部が、前記絶縁層上に位置している請求項 1 に記載のダイオード。

20

【請求項 3】

前記低濃度層に層間絶縁膜を介して対向するとともに前記上面電極に接続されているフィールドプレート電極をさらに備えており、
前記フィールドプレート電極の前記上面電極と反対側の端部が、前記低濃度層上に位置している、請求項 1 または 2 に記載のダイオード。

【請求項 4】

前記層間絶縁膜の比誘電率が、 SiO_2 の比誘電率よりも大きい、請求項 3 に記載のダイオード。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

30

【0001】

本明細書で開示する技術は、ダイオードに関する。

【背景技術】

【0002】

特許文献 1 に、n 型の半導体基板と、半導体基板の上面の一部に接しているアノード電極と、半導体基板の下面に接しているカソード電極とを備える SBD (Schottky Barrier Diode の略) が開示されている。半導体基板内には、カソード電極とオーミック接触する n⁺ 型半導体層と、n⁺ 型半導体層上に形成されているとともに、アノード電極とショットキー接触する n 型半導体層とが形成されている。また、アノード電極の端部に接する範囲には p 型半導体層が形成されることが開示されている。p 型半導体層は、n 型半導体層の上面近傍に留まり、n⁺ 型半導体層から離間している。p 型半導体層を利用するとアノード電極の端部近傍に生じやすい電界集中を緩和することができ、逆方向耐圧を改善することができる。

40

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【特許文献 1】特開 2013 - 102081 号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

50

特許文献 1 の S B D において、アノード電極の端部に接する範囲に p 型半導体層を形成できない場合がある。例えば、半導体基板中の各領域の配置上の制約や、S B D の製造工程における制約により、アノード電極の端部に接する範囲に p 型半導体層を形成できない場合がある。その場合、p 型半導体層に代えて、低濃度の n 型半導体層を形成するか、あるいは i 型の半導体層（即ち、不純物を意図的には添加していない領域）を形成することが想定される。そのような S B D の一例を図 8 に示す。図 8 の S B D 5 0 2 では、p 型半導体層に代えて、低濃度の n 型半導体層である低濃度層 5 3 4 が設けられている。S B D 5 0 2 は、n 型の半導体基板 5 0 4 と、アノード電極 5 1 0 と、カソード電極 5 2 0 とを有する。半導体基板 5 0 4 は、高濃度層 5 3 0 と、中濃度層 5 3 2 と、低濃度層 5 3 4 とを有している。高濃度層 5 3 0 と、中濃度層 5 3 2 と、低濃度層 5 3 4 はいずれも n 型半導体層である。アノード電極 5 1 0 は、中濃度層 5 3 2 の上面にショットキー接触している。

10

【0005】

図 8 の S B D 5 0 2 において、アノード電極 5 1 0 とカソード電極 5 2 0 の間に逆方向バイアスを印加すると、ショットキー界面（即ち、上面電極 5 1 0 と中濃度層 5 3 2 との界面）から半導体基板 5 0 4 内に向けて延びる空乏層 5 9 0 が形成される。空乏層 5 9 0 は、中濃度層 5 3 2 及び低濃度層 5 3 4 内に形成される。また、低濃度層 5 3 4 は、中濃度層 5 3 2 よりも n 型不純物濃度が低いため、低濃度層 5 3 4 内では中濃度層 5 3 2 内に比べて空乏層 5 9 0 が延びやすい。図 8 では、空乏層 5 9 0 内の電位分布を示す等電位線を仮想的に図示している（図中の破線参照）。図 8 に示すように、低濃度層 5 3 4 内では、中濃度層 5 3 2 内に比べて、等電位線同士の間隔が比較的大きい。しかしながら、図 8 の S B D 5 0 2 では、低濃度層 5 3 4 は、中濃度層 5 3 2 の上面近傍に留まり、高濃度層 5 3 0 から離間している。そのため、空乏層 5 9 0 が延びた際に、低濃度層 5 3 4 の下側の中濃度層 5 3 2 で、低濃度層 5 3 4 内に比べて等電位線同士の間隔が狭くなる部分が発生し、高電界が発生する。そのため、アノード電極 5 1 0 の端部近傍における電位の変化が不規則になり、アノード電極 5 1 0 の端部近傍における電界集中を十分に緩和することができない。そのため、S B D の高い耐圧を実現することができない。

20

【0006】

本明細書では、上面電極の端部近傍に p 型半導体層を形成することなく、高い耐圧を実現することができる技術を開示する。

30

【課題を解決するための手段】

【0007】

本明細書が開示するダイオードは、半導体基板と、半導体基板の上面の一部に接している上面電極と、半導体基板の下面の少なくとも一部に接している下面電極を備えている。半導体基板は、下面電極にオーミック接触する n 型の高濃度層と、高濃度層上の一部に形成されているとともに、高濃度層より n 型不純物濃度が低い n 型の中濃度層と、高濃度層上において中濃度層を一巡する範囲に形成されているとともに、中濃度層より n 型不純物濃度が低い n 型の低濃度層を備えている。上面電極は、中濃度層の上面にショットキー接触しており、上面電極と半導体基板が接している接触領域が中濃度層を越えて低濃度層上に及んでいる。ここでいう中濃度層は、上面電極にショットキー接触する n 型不純物濃度の半導体層である。また、低濃度層は、いわゆる i 型の半導体層であってもよい。

40

【0008】

上記の構成によると、低濃度層は、高濃度層の上面に接しており、高濃度層から離間していない。また、上面電極は、中濃度層の上面にショットキー接触しているとともに低濃度層上に及んでいる。そのため、逆バイアス印加時の上面電極の端部近傍における電位の変化が不規則になり難くなる。そのため、上面電極の端部近傍における電界集中を十分に緩和することができる。そのため、上面電極の端部近傍に p 型半導体層を形成することなく、高い耐圧を実現することができる。

【図面の簡単な説明】

【0009】

50

【図 1】第 1 実施例の S B D 2 の断面図。

【図 2】図 1 の S B D 2 の逆バイアス印加時の状態を示す図。

【図 3】第 2 実施例の S B D 1 0 2 の断面図。

【図 4】図 3 の S B D 1 0 2 の逆バイアス印加時の状態を示す図。

【図 5】第 3 実施例の S B D 2 0 2 の断面図。

【図 6】図 5 の S B D 2 0 2 の逆バイアス印加時の状態を示す図。

【図 7】第 4 実施例の S B D 3 0 2 の断面図。

【図 8】比較例の S B D 5 0 2 の逆バイアス印加時の状態を示す図。

【発明を実施するための形態】

【0010】

10

(第 1 実施例)

図 1 に示すように、本実施例の S B D 2 は、半導体基板 4 と、上面電極 1 0 と、下面電極 2 0 と、を有する。

【0011】

半導体基板 4 は、 Ga_2O_3 によって形成されている n 型の半導体基板である。半導体基板 4 は、高濃度層 3 0 と、中濃度層 3 2 と、低濃度層 3 4 とを有している。高濃度層 3 0、中濃度層 3 2、低濃度層 3 4 は、いずれも n 型の半導体層である。変形例では、低濃度層 3 4 は、i 型の半導体層であってもよい。

【0012】

高濃度層 3 0 は、半導体基板 4 の下面全面に露出する範囲に形成されている。中濃度層 3 2 は、高濃度層 3 0 上の一部に形成されている。中濃度層 3 2 の上面は半導体基板 4 の上面に露出する。中濃度層 3 2 の n 型不純物濃度は、高濃度層 3 0 の n 型不純物濃度よりも低い。ここでいう不純物濃度は、当該層における平均不純物濃度のことを意味する。中濃度層 3 2 は、S B D 2 のドリフト層として機能する。低濃度層 3 4 は、高濃度層 3 0 上において中濃度層 3 2 を一巡する範囲に形成されている。低濃度層 3 4 は、半導体基板 4 の側面（図示省略）に到達している。低濃度層 3 4 の上面も、半導体基板 4 の上面に露出する。低濃度層 3 4 の n 型不純物濃度は、中濃度層 3 2 の n 型不純物濃度よりも低い。また、中濃度層 3 2 の比誘電率は、低濃度層 3 4 の比誘電率よりも小さい。

20

【0013】

上面電極 1 0 は、半導体基板 4 の上面の一部に接して形成されている。上面電極 1 0 は、中濃度層 3 2 の上面にショットキー接触している。ただし、上面電極 1 0 と半導体基板 4 とが接している接触領域は、中濃度層 3 2 を越えて低濃度層 3 4 上に及んでいる。上面電極 1 0 は、S B D 2 のアノード電極として機能する。

30

【0014】

下面電極 2 0 は、半導体基板 4 の下面に接して形成されている。下面電極 2 0 は、高濃度層 3 0 の下面にオーミック接触している。下面電極 2 0 は、S B D 2 のカソード電極として機能する。本実施例では、半導体基板 4 の下面の全域に下面電極 2 0 が形成されている。変形例では、下面電極 2 0 は、半導体基板 4 の下面の一部に接していてもよい。

【0015】

次に、本実施例の S B D 2 の動作を説明する。上面電極 1 0 と下面電極 2 0 の間に、上面電極 1 0 がプラスとなる電圧（即ち順方向バイアス）を印加すると、半導体基板 4 側から上面電極 1 0 に向かって電子が移動する。これにより、上面電極 1 0 から下面電極 2 0 に電流が流れる。

40

【0016】

また、上面電極 1 0 と下面電極 2 0 の間に、下面電極 2 0 がプラスとなる電圧（即ち逆方向バイアス）を印加すると、図 2 に示すように、ショットキー界面（即ち、上面電極 1 0 と中濃度層 3 2 との界面）から半導体基板 4 内に向けて延びる空乏層 9 0 が形成される。空乏層 9 0 は、中濃度層 3 2 及び低濃度層 3 4 内に形成されるが、n 型不純物濃度が高い高濃度層 3 0 内には延びない。また、低濃度層 3 4 は、中濃度層 3 2 よりも n 型不純物濃度が低いため、低濃度層 3 4 内では中濃度層 3 2 内に比べて空乏層 9 0 が延びやすい。

50

図 2 では、空乏層 90 内の電位分布を示す等電位線を仮想的に図示している（図中の破線参照）。低濃度層 34 の比誘電率は中濃度層 32 の比誘電率よりも大きいため、図 2 に示すように、低濃度層 34 内では、中濃度層 32 内に比べて、等電位線同士の間隔が比較的大きい。また、上記の通り、低濃度層 34 は、高濃度層 30 上において中濃度層 32 を一巡する範囲に形成されており、高濃度層 30 と離間していない。そのため、上面電極 10 の端部近傍の電位分布の間隔（即ち、等電位線の間隔）がほぼ一定になり、上面電極 10 の端部近傍における電位の変化が不規則になり難くなる。そのため、上面電極 10 の端部近傍における電界集中を十分に緩和することができる。そのため、本実施例の SBD2 では、上面電極 10 の端部近傍に p 型半導体層を形成することなく、高い耐圧を実現することができる。また、本実施例では、半導体基板 4 が、p 型半導体層を形成することが困難な材料である Ga_2O_3 によって形成されているため、p 型半導体層を利用しない本実施例の SBD2 の構造が特に有用である。

10

【0017】

（第 2 実施例）

続いて、図 3、図 4 を参照して、第 2 実施例の SBD102 について、第 1 実施例と異なる点を中心に説明する。図 3、図 4 では、第 1 実施例の SBD2 と同様の要素は図 1 と同じ符号を用いて示し、詳細な説明を省略する。本実施例の SBD102 は、層間絶縁膜 40 と、フィールドプレート電極 16 と、保護膜 50 とをさらに有する点で、第 1 実施例の SBD2 とは異なる。

20

【0018】

層間絶縁膜 40 は、半導体基板 4 の上面のうち、上面電極 10 と接していない範囲に配置されている。層間絶縁膜 40 は、 ZrO_2 によって形成されている。変形例では、層間絶縁膜 40 は HfO_2 によって形成されていてもよい。層間絶縁膜 40 の比誘電率は SiO_2 の比誘電率よりも大きく、また、低濃度層 34 の比誘電率よりも大きい。

【0019】

フィールドプレート電極 16 は、上面電極 10 と連続して形成されている。フィールドプレート電極 16 は、層間絶縁膜 40 を介して低濃度層 34 と対向している。フィールドプレート電極 16 の端部（即ち、上面電極 10 と反対側の端部）16a は、低濃度層 34 の上方に位置している。

30

【0020】

保護膜 50 は、上面電極 10 の一部と、フィールドプレート電極 16 と、層間絶縁膜 40 の一部とを覆う絶縁膜である。保護膜 50 は、ポリイミドによって形成されている。

【0021】

次に、本実施例の SBD102 の動作を説明する。SBD102 に順方向バイアスを印加する場合の動作は第 1 実施例の SBD2 の場合と同様であるため、説明を省略する。一方、SBD102 に逆方向バイアスを印加すると、図 4 に示すように、半導体基板 4 及び層間絶縁膜 40 内に延びる空乏層 190 が形成される。本実施例では、上面電極 10 と連続しているフィールドプレート電極 16 が設けられているため、空乏層 190 は上面電極 10 の端部から側方に離れた位置まで延びる。このため、上面電極 10 への端部近傍への電界集中をさらに緩和することができる。また、フィールドプレート電極 16 の上面電極 10 と反対側の端部 16a が低濃度層 34 の上方に位置しているため、フィールドプレート電極 16 の端部 16a 近傍への電界集中も十分に緩和することができる。また、上記の通り、層間絶縁膜 40 の比誘電率は、 SiO_2 の比誘電率よりも大きい。そのため、層間絶縁膜 40 における空乏層 190 内の等電位線の間隔が比較的広くなる。これにより、上面電極 10 への端部近傍への電界集中の緩和効果が十分に発揮される。従って、上記の通り、本実施例の SBD102 によると、上面電極 10 への端部近傍への電界集中をさらに緩和することができるとともに、フィールドプレート電極 16 の端部 16a 近傍への電界集中も十分に緩和することができる。そのため、本実施例の SBD102 でも、高い耐圧を実現することができる。

40

【0022】

50

(第3実施例)

続いて、図5、図6を参照して、第3実施例のSBD202について、第2実施例と異なる点を中心に説明する。図5、図6でも、上記の各実施例のSBD2、102と同様の要素は同じ符号を用いて示し、詳細な説明を省略する。本実施例のSBD202は、低濃度層34内に、絶縁層36がさらに備えられている点が第2実施例のSBD102と異なる。

【0023】

絶縁層36は、低濃度層34内において、中濃度層32を一巡する範囲に形成されている。絶縁層36は、低濃度層34にFeをドーピングすることによって形成される。本実施例では、絶縁層36は、半導体基板4の上面近傍に留まり、高濃度層30からは離間している。絶縁層36の比誘電率は、層間絶縁膜40の比誘電率よりも大きい。本実施例では、上面電極10と半導体基板4とが接している接触領域の端部は、絶縁層36上に位置している。

10

【0024】

次に、本実施例のSBD202の動作を説明する。SBD202に順方向バイアスを印加する場合の動作も、上記の各実施例のSBD2、102と同様であるため、詳しい説明を省略する。一方、SBD202に逆方向バイアスを印加すると、図6に示すように、半導体基板4及び層間絶縁膜40内に延びる空乏層290が形成される。本実施例では、低濃度層34内に絶縁層36が設けられているため、上面電極10の端部近傍への電界集中がより緩和される。そのため、本実施例のSBD202でも、高い耐圧を実現することができる。

20

【0025】

(第4実施例)

続いて、図7を参照して、第4実施例のSBD302について、第3実施例と異なる点を中心に説明する。図7でも、上記の各実施例のSBD2、102、202と同様の要素は同じ符号を用いて示し、詳細な説明を省略する。本実施例のSBD302では、上面電極10が、ショットキー電極膜12と積層電極膜14とを積層した構造を有する点が第3実施例とは異なる。

【0026】

図7に示すように、ショットキー電極膜12は、半導体基板4の上面に接している。ショットキー電極膜12は、中濃度層32の上面にショットキー接触している。ただし、ショットキー電極膜12と半導体基板4とが接している接触領域は、中濃度層32を越えて低濃度層34上に及んでいる。また、ショットキー電極膜12の端部は、層間絶縁膜40によって覆われている。ショットキー電極膜12の端部を覆っている側の層間絶縁膜40の端部は、低濃度層34上に位置している。積層電極膜14は、層間絶縁膜40で覆われていないショットキー電極膜12に積層されている。積層電極膜14は、フィールドプレート電極16に連続している。

30

【0027】

本実施例のSBD302の動作は、第3実施例のSBD202の動作とほぼ同様であるため、詳しい説明を省略する。上記の通り、本実施例のSBD302では、ショットキー電極膜12の端部が層間絶縁膜40によって覆われている。そのため、SBD302を製造する際に、半導体基板4の上面にショットキー電極膜12を形成した後に層間絶縁膜40を形成することができる。そのため、半導体基板4の上面が清浄である間にショットキー電極膜12を形成することができ、安定したショットキー界面を得ることができる。また、上記の通り、ショットキー電極膜12の端部を覆う側の層間絶縁膜40の端部は、低濃度層34上に位置しており、中濃度層32上には位置しない。そのため、SBD302に順方向バイアスを印加する場合に、導通抵抗が大きくなることもない。

40

【0028】

以上、本明細書に開示の技術の具体例を詳細に説明したが、これらは例示に過ぎず、特許請求の範囲を限定するものではない。特許請求の範囲に記載の技術には、以上に例示し

50

た具体例を様々に変形、変更したものが含まれる。例えば、以下の変形例を採用してもよい。

【0029】

(変形例1) 上記の第1～第3実施例においても、第4実施例と同様に、上面電極10が、半導体基板4の上面に接するショットキー電極膜と、ショットキー電極膜の上面に積層される積層電極膜とを有していてもよい。また、この場合において、フィールドプレート電極16が、ショットキー電極膜と連続する第1膜と、積層電極膜と連続し、第1膜の上面に積層される第2膜とを有していてもよい。

【0030】

(変形例2) 半導体基板4は、GaN, Si, SiC等、Ga₂O₃以外の材料によって形成されていてもよい。特に、半導体基板4がSi又はSiCによって形成される変形例においては、第2～第4実施例の層間絶縁膜40と低濃度層34との間に熱酸化膜をさらに形成してもよい。ただし、半導体基板4が、p型半導体層を形成することが困難な材料であるGaN, Ga₂O₃によって形成されている場合、p型半導体層を利用しない本明細書に開示の構造が特に有用である。

10

【0031】

(変形例3) 低濃度層34は、半導体基板4の側面に到達していなくてもよい。一般的に言うと、低濃度層34は、高濃度層30上において中濃度層32を一巡する範囲に形成されていればよく、上面電極10と半導体基板4の接触領域が中濃度層32を越えて低濃度層34上に及んでいればよい。

20

【0032】

本明細書が開示する技術要素について、以下に列記する。なお、以下の各技術要素は、それぞれ独立して有用なものである。

【0033】

本明細書が開示するダイオードにおいて、低濃度層内において中濃度層を一巡する範囲に形成されている絶縁層をさらに備えていてもよい。接触領域の端部が、絶縁層上に位置していてもよい。

【0034】

この構成によると、絶縁層が備えられていることによって、上面電極の端部近傍への電界集中をより緩和することができる。

30

【0035】

本明細書が開示するダイオードにおいて、低濃度層に層間絶縁膜を介して対向するとともに上面電極に接続されているフィールドプレート電極をさらに備えていてもよい。フィールドプレート電極の上面電極と反対側の端部が、低濃度層上に位置していてもよい。

【0036】

この構成によると、フィールドプレート電極が備えられているため、逆バイアス印加時に、空乏層が上面電極の端部から側方に離れた位置まで延びる。従って、上面電極への端部近傍への電界集中をさらに緩和することができる。また、フィールドプレート電極の上面電極と反対側の端部が低濃度層上に位置しているため、フィールドプレート電極の端部近傍への電界集中も十分に緩和することができる。

40

【0037】

層間絶縁膜の比誘電率がSiO₂の比誘電率よりも大きくてもよい。

【0038】

この構成によると、層間絶縁膜における空乏層内の電位分布の間隔(即ち、等電位線の間隔)が比較的広くなる。そのため、上面電極10への端部近傍への電界集中の緩和効果が十分に発揮される。

【0039】

本明細書または図面に説明した技術要素は、単独であるいは各種の組み合わせによって技術的有用性を発揮するものであり、出願時請求項記載の組み合わせに限定されるものではない。また、本明細書または図面に例示した技術は複数目的を同時に達成するものであ

50

り、そのうちの一つの目的を達成すること自体で技術的有用性を持つものである。

【符号の説明】

【0040】

2 : SBD

4 : 半導体基板

10 : 上面電極

12 : ショットキー電極膜

14 : 積層電極膜

16 : フィールドプレート電極

16a : 端部

20 : 下面電極

30 : 高濃度層

32 : 中濃度層

34 : 低濃度層

36 : 絶縁層

40 : 層間絶縁膜

50 : 保護膜

90 : 空乏層

102 : SBD

190 : 空乏層

202 : SBD

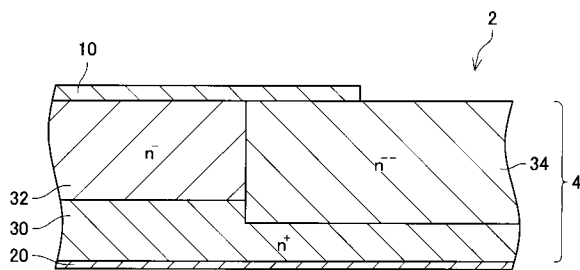
290 : 空乏層

302 : SBD

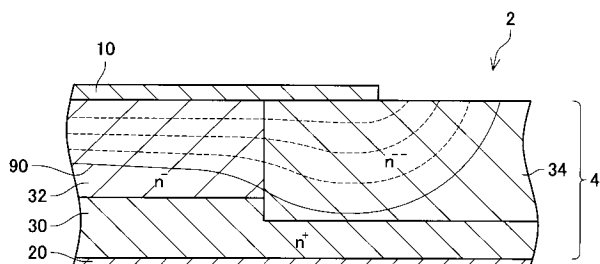
10

20

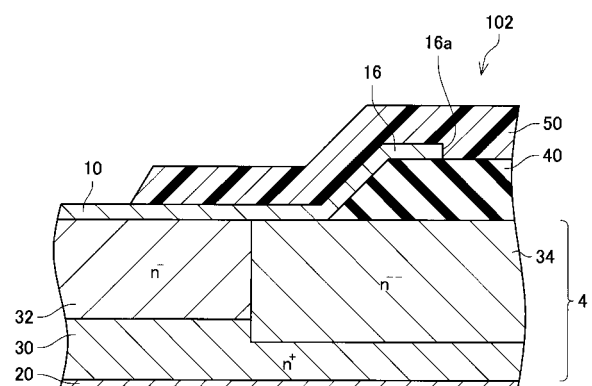
【図1】



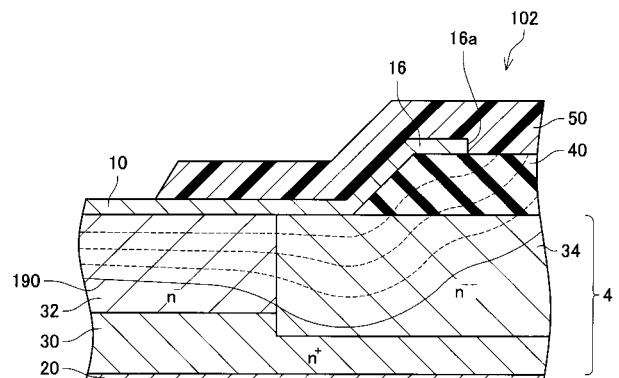
【図2】



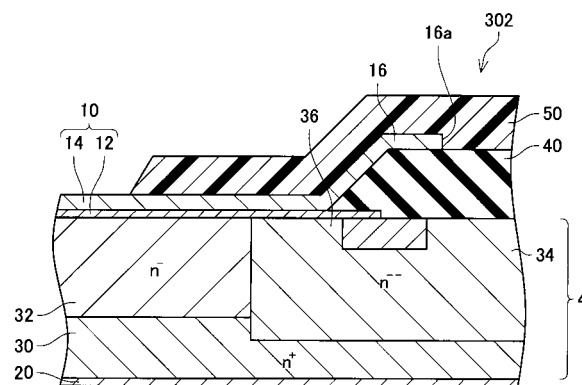
【図3】



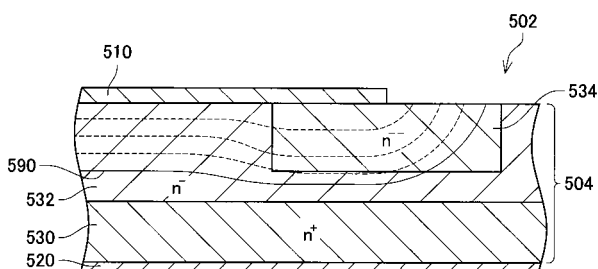
【図4】



【圖 7】



【 図 8 】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.	F I	テーマコード(参考)
	H 0 1 L 29/06	3 0 1 V
	H 0 1 L 29/86	3 0 1 F
	H 0 1 L 29/06	3 0 1 D

(72)発明者 青井 佐智子
愛知県長久手市横道 4 1 番地の 1 株式会社豊田中央研究所内

(72)発明者 浦上 泰
愛知県刈谷市昭和町 1 丁目 1 番地 株式会社デンソー内

F ターム(参考) 4M104 AA01 AA03 AA04 DD26 EE02 EE16 FF02 FF10 FF13 FF36
GG03 HH18